19 th Iranian's Nuclear Conference

# امكانسنجى ساخت حسكرنورى جهت اندازهكيرى انرثى P: \^v <br> ذرات باردار شتابدهنده 

## جكيده:

تابش باريكههاى الكترونى و يونى بر روى مواد باعث تغيير خواص /تپيكى /ز جمله ضريب جنب آنها مىشود. بنابر/ين خواص /تپيكى مو/د مىتو/نند /بز/رى مناسب براى مشخصهيابى /ز خصوصيات كمى وكيفى باريكههاى الكترونى باشنا. اين تحقيق تغييرات ضريب جذب لايه اتپيكى مخصوص دز خورده را با استغاده /ز روش

 تغييرات ضريب جذب لايه /تپيكى ناشى /ز تحريكى القایی لامپ التهابى با استغاده /ز |ندازْكيرى تو/ن عبورى ليزر He-Ne بررسى مى شسو. بررسى /ين تغييرات ما را به ساخت حسگر نورى انزثى شتابدهناه الكترونى رهنمون مىسازد.

و/زههاى كليدى: باريكه الكترونى، شتابدهنده، دز دريافتى، ضريب جذب، لايه
ايتيكى، روش دمش-گمانه.

